	L #	Hits	Search Text	DBs
1	L1	1	110/692/98	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
2	L2	1	11 0 / / 04 / 4 9	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
3	L3	1	11.07.024.5.5.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
4	L4	2789	crystallization with apparatus	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
5	L5	308	母 . l . l .	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
6	L6	355	Haser same 4	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
7	L7	1	11 11 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
8	L8	1	11.07.7.34.248	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
9	L9	77494	amouphous or polycrystalline	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
10	L10	20114	semiconductor with 9	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
11	L11	933912	1	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
12	L12	386613	mask or phoromask or reficie	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
13	L13	232920	ICONCAVE	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
14	L14	15423	11 1 W 1 1.(1 1 Z	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
15	L15	239		US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
16	L16	40	0 14	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
17	L17	239	11.5 1.4	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
18	L18	30	16 15	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
19	L19	13	16 13	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
20	L20	232907	13 not 19	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
21	L21	13	11.5 1101 20	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO